## 高 AI 組成 AIGaN/AIN 量子井戸における光学利得特性の井戸幅依存性

Well Width Dependence of Optical Gain Properties in Al-rich AlGaN/AlN Quantum Wells 京大院工 <sup>0</sup>大音 隆男, ライアン バナル, 船戸 充, 川上 養一

Dept. of Electronic Sci. and Eng., Kyoto Univ.

<sup>°</sup>Takao Oto, Ryan G. Banal, Mitsuru Funato, and Yoichi Kawakami

E-mail: takao.oto@optomater.kuee.kyoto-u.ac.jp, kawakami@kuee.kyoto-u.ac.jp

<u>はじめに</u>:水の殺菌や半導体プロセス等を応用に据えた次世代の深紫外光源 として、AlGaN を用いた発光素子が着目され、研究が盛んに行われている. 深紫外領域において、すでに光ポンピングによってレーザ発振が実現され[1]、 近年にAlGaN 量子井戸(Quantum Well: QW)の光学利得についての報告[2]もさ れているが、実験的に得られた光学利得特性から、レーザ構造設計について 議論した報告はない.光学利得特性を理解することは、発振閾値の低減化な どデバイスへの応用上非常に重要であると考えられる.そこで本研究では、 レーザに最適な構造を探索するため、井戸幅の異なる高 Al 組成 AlGaN/AIN QW に対して光学利得特性の評価を行った.

実験方法:測定に用いた試料は、(0001) sapphire 基板上に Modified MEE 法で 厚さ~600 nm の AlN を成長させ、その上に井戸幅  $L_w$  の Al<sub>0.79</sub>Ga<sub>0.21</sub>N/AlN QW を 10 周期作製した構造である[3].光学利得特性を評価するために、室温で 励起長可変法の測定を行った.励起長可変法とは、励起長 L を変化させて端 面 PL(Photoluminescence)測定を行い、端面から観測される増幅された自然放 出光(Amplified Spontaneous Emission: ASE)の強度  $I_{ASE}$  が  $I_{ASE} = I_{sp} \{ \exp(G_{mod} L) - 1 \} / G_{mod} \cdots (1)$ のように変化することから、モード利得  $G_{mod} (= \Gamma g_{mat} - \alpha)$ を 得る方法である[4].ただし、 $I_{sp}$  は自然放出光の強度、 $\Gamma$ は光閉じ込め係数、 $g_{mat}$  はマテリアルゲイン、 $\alpha$ は内部損失である.

実験結果と考察:励起長可変法の測定の一例として、図 1(a)に励起密度 140  $kW/cm^2$ において,  $L_w = 5 nm$ のQWの端面PLスペクトルの励起長依存性を 示す. なお, Lは50 µm から500 µm まで50 µm 間隔で測定を行った. その 結果, Lに対して PL 強度が超線形的に増加していた.光学利得が飽和しない 領域で、式(1)を基に利得スペクトルを算出した結果を図1(b)に示す.最大で ~120 cm<sup>-1</sup>の G<sub>mod</sub>が得られた. さらに, 井戸幅が光学利得特性に与える影響を 調べるために, 井戸幅の異なる QW に対して同様の測定を行った. 図2 に最 大の $G_{mod}$ の井戸幅依存性を示す.励起強度を大きくするにしたがって、 $G_{mod}$ が大きくなるという妥当な傾向が得られた.また、 $G_{mod}$ は $L_w = 5 \text{ nm} O \text{QW}$ で最大になっていたが、その理由を以下に考察する. 前述したように Gmod は $\Gamma$ に大きく依存するため、各QWに対してTEモードの $\Gamma$ を計算した(図3). L<sub>w</sub>=2.5 nmのQWは、L<sub>w</sub>=5 nmのQWに比べて光閉じ込めが42%に減少し ており, このことが G<sub>mod</sub>の減少を引き起こしている主な原因であると考えら れる. 一方,  $L_w = 10 \text{ nm} \text{ or } QW$ では $G_{mod} < 0$ となっていたが, これは電子と 正孔の波動関数の重なりが大きく減少し、輻射再結合確率が低下しているこ とが原因であると考えられる.詳細な結果や考察は、当日に報告する.

[1] T. Takano *et al.*, *Appl. Phys. Lett.* 84, 3567 (2004).
[2] E. F. Pecora *et al.*, *Appl. Phys. Lett.* 100, 061111 (2012).
[3] R. G. Banal *et al.*, *Phys. Stat. Sol.* (*c*) 7, 2111 (2010).
[4] K. Shaklee *et al.*, *J. Lumin.* 7, 284 (1973).



Fig. 1: (a) Excitation length dependence of PL spectra and (b) optical gain spectra in  $Al_{0.79}Ga_{0.21}N/AIN$  QW with  $L_w=5$  nm



gain in Al<sub>0.79</sub>Ga<sub>0.21</sub>N/AlN QWs.



Fig. 3: Calculated optical confinement factor in Al<sub>0.79</sub>Ga<sub>0.21</sub>N/AlN QWs.